

Dioden, Gleichrichterdiolen, Thyristoren
 ДИОДЫ, ВЫПРЯМИТЕЛИ, ТИРИСТОРЫ
 Diodes, rectifier diodes, thyristors

Si-Kapazitätsdioden
 Кремниевые варикапы
 Si-variable capacitance diodes

Typ Kenndaten bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$

	P_{tot} mW	U_R V	c_j pF	f_Q GHz	bei U_R V	L_s nH	I_{th} μA	bei U_R V	C_c pF
SAZ 12	300	18	1...5	>10	6	3,5	<10	18	0,4
SAZ 13	300	18	1...5	>20	6	3,5	<10	18	0,4

Si-Varaktordioden
 Кремниевые варакторы
 Si-varactor diodes

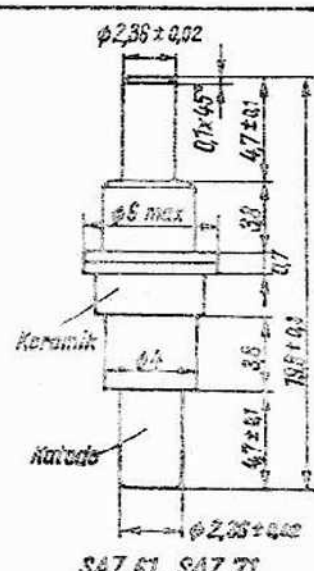
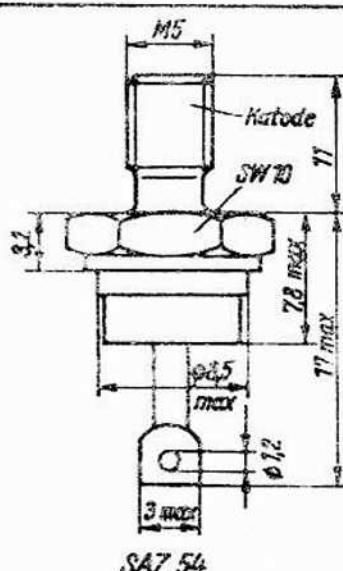
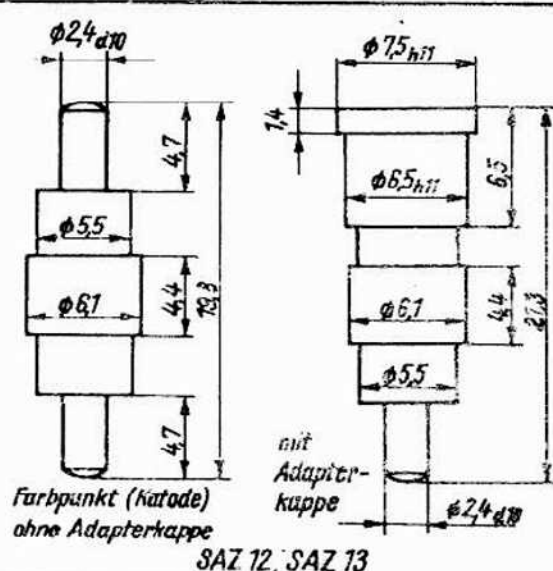
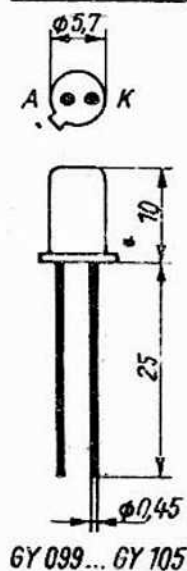
Typ Kenndaten bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$

	P_{in} W	$\hat{U}_{\text{RR}}$ V	I_F mA	$U_{(\text{BR})}$ V	bei I_R μA	c_j pF	f_Q GHz	bei U_R V	L_s nH	t_s ns	bei U_R V	C_c pF	R_{thi} grd/W
SAZ 54	6	90	10	>90	100	4,0...8,0	>20	6	<2	>12	6	0,8	<10
SAZ 61	1,5	60	10	>60	10	0,5...1,0	>100	6	<1,5	>3	6	0,45	<100
SAZ 71	1	30		>30	10	0,3...0,5	>150	6	<1,5			0,45	<200

Ge-Gleichrichterdiolen
 Германиевые выпрямительные диоды
 Ge-rectifier diodes

Typ Kenndaten bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$

	U_R V	$\hat{U}_{\text{RR}}$ V	I_{FN} A	$\hat{I}_{\text{FR}}$ A	U_F V	I_R μA
GY 099	12	12				<100
GY 100	24	24				<100
GY 101	40	40				<100
GY 102	75	75	0,1	0,35	<0,5	<100
GY 103	100	100				<100
GY 104	150	150				<50
GY 105	200	200				<50



Kurzzzeichen

A	wirksame Fläche	I _Z	Z-Strom	U _{CEsat}	Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung
C _c	Gehäusekapazität	ΔI _Z	Stabilität des Z-Stroms	U _{CEV}	Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei in Sperrrichtung vorge- spannter Emitterdiode
C _{gss}	Eingangskapazität	I _O	Ausgangsstrom	U _D	Blockierspannung
C _j	Sperrschichtkapazität	I _O	Richtstrom	U _{DB}	Drain-Bulk-Spannung
C _L	Lastkapazität	ΔI _O	Richtstromdifferenz	U _{DG}	Drain-Gate-Spannung
C _{tot}	Gesamtkapazität	l	Länge	U _{DM}	Scheitelblockier- spannung
CMR	Gleichtaktunter- drückung	L	Leuchtdichte	Ū _{DR}	Periodische Spitzen- blockierspannung
d _ü	Übertragungsdämpfung	L _S	Serieninduktivität	Ū _{DS}	Nichtperiodische Spitzenblockierspannung
E	Beleuchtungsstärke	N _O	Ausgangslastfaktor	U _{DS}	Drain-Source-Spannung
F	Rauschfaktor	P _{in}	HF-Eingangsleistung	U _e	Eingangsspannung
f	Frequenz	P _{RS}	Nichtperiodische Sperrverlustleistung	U _{EBO}	Emitter-Basis-Sperr- spannung
f _{h21b}	Grenzfrequenz in Basisschaltung	P _{tot}	Totale Verlustleistung	U _F	Durchlaßgleichspannung
f _{h21e}	Grenzfrequenz in Emitterschaltung	R _{äq}	Äquivalentwiderstand	U _{GB}	Gate-Bulk-Spannung
f _Q	Gütegrenzfrequenz	R _{BE}	Basis-Emitter-Wider- stand	U _{GS}	Gate-Source-Spannung
f _T	Transitgrenzfrequenz	R _{DS}	Drain-Source-Widerstand	U _{GT}	Zündspannung
G _{pb}	HF-Leistungsverstärkung in Basisschaltung	R _e	Eingangswiderstand	U _{HF}	HF-Spannung
h	Höhe	R _g	Generatorwiderstand	U _I	Gleichtakteingangs- spannung
h _{21E}	Gleichstromverstärkung	R _L	Lastwiderstand	U _{ID}	Differenzeingangs- spannung
h _{21e}	Kurzschlußstromverstär- kung in Emitterschaltung	R _{th}	Gesamtwärmewiderstand	U _{IO}	Eingangsoffsetspannung
I _B	Basisstrom	R _{thi}	Innerer Wärmewiderstand	U _R	Sperrspannung, Sperrgleichspannung
I _C	Kollektorstrom	r _F	Durchlaßwiderstand	U _{RM}	Scheitelsperrspannung
I _{CBO}	Kollektorreststrom bei offenem Emitter	r _R	Sperrwiderstand	Ū _{RR}	Periodische Spitzen- sperrspannung
I _{CES}	Kollektor-Emitter- Reststrom	r _Z	Z-Widerstand	Ū _{RS}	Nichtperiodische Spitzenperrspannung
I _{CEV}	Kollektorreststrom bei in Sperrrichtung vorge- spannter Emitterdiode	S	Empfindlichkeit	U _S	Betriebsspannung
I _D	Drainstrom	t _{DHL}	Einschaltverzögerungs- zeit	U _{SB}	Source-Bulk-Spannung
I _D	Blockierstrom	t _{DLH}	Ausschaltverzögerungs- zeit	U _T	Schwellspannung
Ū _{DR}	Drainspitzenstrom	t _{gt}	Zündzeit	U _Z	Z-Spannung
I _e	Strahlstärke	t _{off}	Ausschaltzeit	ΔU _Z	Stabilität der Z-Spannung
I _F	Flußstrom, Durchlaß- gleichstrom	t _{on}	Einschaltzeit	U _{OH}	High-Ausgangsspannung
I _F	Dauergrenzstrom	t _q	Freiwerdzeit	U _{OL}	Low-Ausgangsspannung
I _F	Effektiver Durchlaß- strom	t _r	Anstiegzeit	V _U	Spannungsverstärkung
I _{FM}	Scheiteldurchlaßstrom	t _{rr}	Sperrerholungszeit	Y ₂₁	Steilheit
I _{FN}	Nenndurchlaßstrom, Nenngleichstrom	t _s	Speicherzeit	θ _a	Umgebungstemperatur
Ū _{FR}	Periodischer Spitzen- strom	TK _{UZ}	Temperaturkoeffizient der Z-Spannung	θ _c	Gehäusetemperatur
Ū _{FS}	Nichtperiodischer Spitzenstrom	U _{AN}	Nennanschlußspannung (Effektivwert)	θ _j	Sperrschichttemperatur
I _{GT}	Zündstrom	U _{BE}	Basis-Emitter-Spannung	Δθ	Temperaturdifferenz
I _H	Haltestrom	U _(BR)	Durchbruchspannung	λ	Emissionswellenlänge
I _I	Eingangsbiassstrom	U _{CB}	Kollektor-Basis- Spannung	λ _p	Wellenlänge maximaler Emission
I _{IO}	Eingangsoffsetstrom	U _{CBO}	Kollektor-Basis- Sperrspannung	Δλ	Spektrale Halbwerts- breite
I _R	Sperrstrom	U _{CE}	Kollektor-Emitter- Spannung	τ _i	Einschaltzeitkonstante
I _T	Durchlaßstrom	U _{CEO}	Kollektor-Emitter- Sperrspannung bei offener Basis		
I _T	Dauergrenzstrom	U _{CER}	Kollektor-Emitter- Sperrspannung bei end- lichem Basis-Emitter- Widerstand		
I _T	Effektiver Durchlaßstrom	U _{CERest}	Kollektorrestspannung		
Ū _{TR}	Periodischer Spitzen- strom	U _{CES}	Kollektorsperrspannung bei kurzgeschlossenem Emitterdiode		